

(Q) timing monolithic integrated circuits, multichip integrated circuits, film-type integrated circuits or hybrid integrated circuits that have

(I) a typical timing error of not less than ± 0.5 per cent, and

(II) a typical rise time of not less than 100 ns,

(R) voltage monolithic integrated circuits, multichip integrated circuits, film-type integrated circuits or hybrid integrated circuits that are

(I) voltage comparators that have

1. a maximum input offset voltage of not less than 2 mV, and

2. a typical switching speed, that is, a typical response time, of not less than 30 ns,

(II) voltage references that have

1. a rated accuracy of not better than ± 0.1 per cent, and

2. a temperature coefficient of the voltage of not less than $15 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$,

(III) linear-type voltage regulators whose temperature rating may be greater than 85°C and that have

1. a rated nominal output voltage of 50 V or less, and

2. a maximum output current of 2 A or less, and

(IV) switching-type voltage regulators whose temperature rating may be greater than 85°C and that have

1. a rated nominal output voltage of 40 V or less, and

2. a maximum output current of 150 mA or less,

(S) non-coherent light-emitting alphanumeric displays that do not incorporate other monolithic integrated circuits,

(T) non-coherent light-emitting alphanumeric displays that incorporate monolithic integrated circuits that are

(I) used for decoding, controlling or driving the display, and

(II) not integral to the actual display device, or

(U) encapsulated photocoupler or transopter optical integrated circuits that have

(I) an electrical input and output, and

(II) any incorporated light-emitting diode that can only emit non-coherent light,

(iii) unencapsulated integrated circuits that

(A) are based exclusively on silicon,

(B) are not designed or rated as radiation-hardened, and

(C) are

(I) bipolar monolithic integrated circuits, other than complex custom-built bipolar digital monolithic integrated circuits, that

(Q) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides de synchronisation qui ont, à la fois:

(I) une erreur de synchronisation typique d'au moins $\pm 0,5$ pour cent,

(II) un temps de montée typique d'au moins 100 ns,

(R) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micro-plaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides de tension, à savoir:

(I) comparateurs de tension qui ont à la fois:

1. une tension résiduelle d'entrée maximale d'au moins 2 mV,

2. une vitesse de commutation typique, soit un temps de réponse typique, d'au moins 30 ns,

(II) références de tension qui ont à la fois:

1. une précision nominale d'au plus $\pm 0,1$ pour cent,

2. un coefficient de température de tension d'au moins $15 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$,

(III) régulateurs de tension linéaires dont la limite de température peut être supérieure à 85°C , qui ont à la fois:

1. une tension de sortie nominale prévue d'au plus 50 V,

2. un courant de sortie maximal d'au plus 2 A,

(IV) régulateurs de tension à découpage dont la limite de température peut être supérieure à 85°C , qui ont à la fois:

1. une tension de sortie nominale prévue d'au plus 40 V,

2. un courant de sortie maximal d'au plus 150 mA,

(S) visuels alphanumériques émettant de la lumière non cohérente ne comprenant pas d'autres circuits intégrés monolithiques,

(T) visuels alphanumériques émettant de la lumière non cohérente comprenant des circuits intégrés monolithiques qui sont à la fois:

(I) utilisés pour décoder, commander ou entraîner le visuel,

(II) non intégrés au visuel,

(U) circuits intégrés optiques photocoupleurs ou transducteurs optiques, encapsulés, qui présentent les caractéristiques suivantes:

(I) une entrée et une sortie électriques,

(II) toute diode incorporée qui émet de la lumière ne peut qu'émettre de la lumière non cohérente,

(iii) circuits intégrés non encapsulés qui à la fois:

(A) sont uniquement à base de silicium,

(B) ne sont pas conçus comme circuits durcis aux radiations,

(C) appartiennent à l'un des types suivants:

(I) circuits intégrés monolithiques bipolaires, à l'exclusion des circuits intégrés monolithiques numériques bipolaires complexes faits sur mesure, qui à la fois: